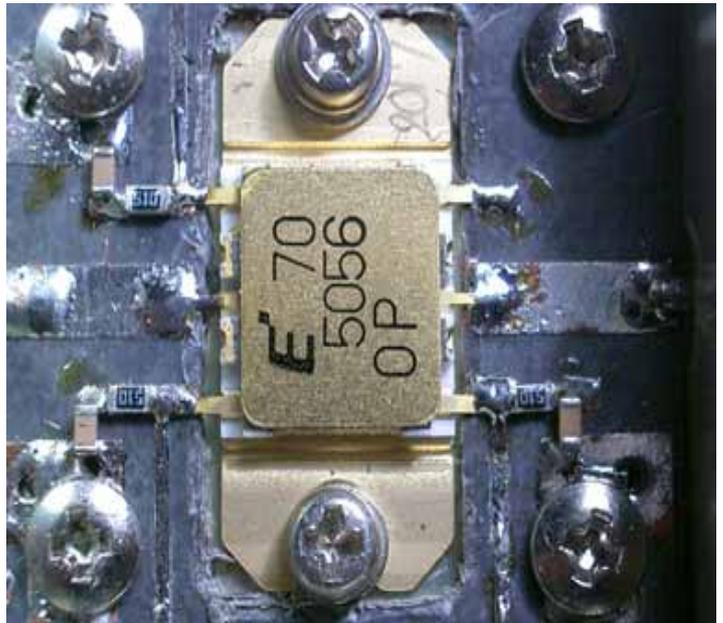


10GHz帯アンプと同様なMMICで5GHzパワーアンプを製作。基板は、RT/duroid テフロン両面基板:0.8t (サイズ:24.8*34.4mm)を使い、入力+5dBmで出力+34dBm・利得:28dBの特性が得られました。

供給電源基板は、セブロン電子製FETバイアス基板を使いゲート電圧用5vとドレイン電圧用+10Vです。

調整は、ドレイン電圧を+10vに合わせるだけで、基板のスタブ調整は必要がありませんでした。ただケースに蓋をすると、レベルが落ち、手持ちの電波吸収ゴムをケース蓋の裏に張り、改善した。これは10GHz帯MMICと同じでした。



ケースはセブロン電子製10GHz帯MMICのAMP用のアルミケースを利用。電源供給用貫通端子を上下反対に取り付けて代用しました

アンプ用ケースサイズ参考図

